

	<h2 style="color: #E67E22;">FQE10N20LCTU</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQE10N20LCTU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 4A TO-126
	Datenblätter:  FQE10N20LCTU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FQE10N20LCTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 4A TO-126
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-126
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	12.8W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-225AA, TO-126-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	490pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 4A (Tc) 12.8W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

FQE10N20LCTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQE10N20LCTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQE10N20LCTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQE10N20LCTU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFB17N60K Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 17A TO-220AB</p>	 <p>FQE10N20CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4A TO-126</p>	 <p>JANTX2N6784 Microsemi Corporation MOSFET N-CH TO-205AF TO-39</p>	 <p>STW13NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 12A TO-247</p>
 <p>DMN10H170SFDE-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.9A 6UDFN</p>	 <p>FQE10N20LCTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4A TO-126</p>	 <p>IRL3705NSTR Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 89A D2PAK</p>	 <p>FDFS6N754 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 4A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQE10N20LCTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQE10N20LCTU Datenblatt	FQE10N20LCTU-Datenblätter	FQE10N20LCTU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQE10N20LCTU
FQE10N20LCTU Electronic	FQE10N20LCTU-Komponenten	FQE10N20LCTU-Verteiler	FQE10N20LCTU-Bild	FQE10N20LCTU-Teil
FQE10N20LCTU Preis	FQE10N20LCTU Hersteller	FQE10N20LCTU Bild	FQE10N20LCTU Aktie	FQE10N20LCTU Inventar
FQE10N20LCTU Neu	FQE10N20LCTU Original	FQE10N20LCTU garantiert	FQE10N20LCTU RFQ	FQE10N20LCTU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited